

# 電流制御型 KP シリーズ

TSS KP SERIES

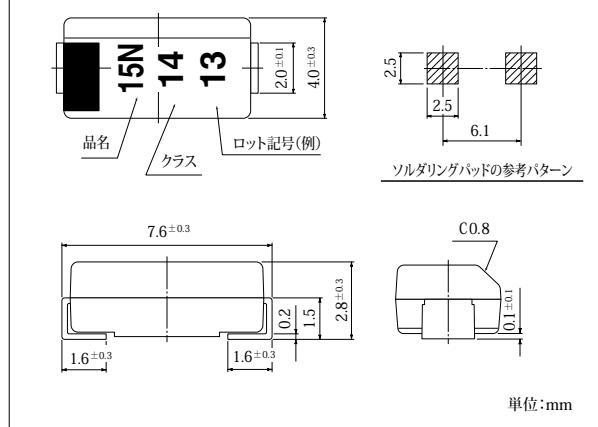
面実装品 (SMD)

**KP15N14**

140V150A

## ■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Package : 2F



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

## ■定格表 RATINGS

### ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T<sub>1</sub>=25°C / unless otherwise specified)

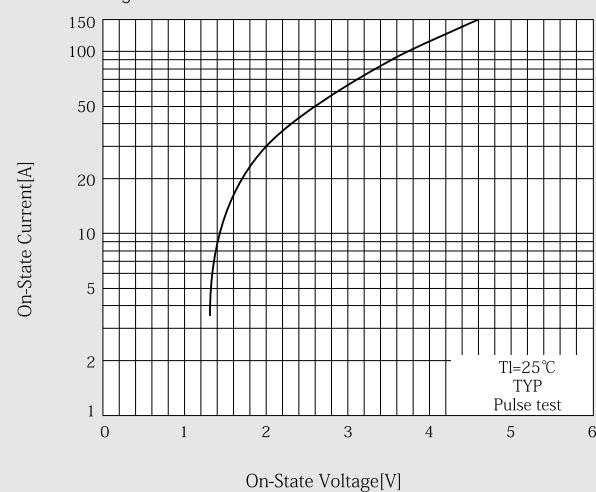
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>		-40~125	°C	
接合部温度 Junction Temperature	T <sub>j</sub>		125	°C	
オフ電圧 Maximum Off-State Voltage	V <sub>DRM</sub>		120	V	
せん頭サージ電流 Surge On-State Current	I <sub>TSMS</sub>	10/1000 μ s	非繰り返し Non-repetitive	150	A

### ●電気的特性 T<sub>1</sub>=25°C Electrical Characteristics T<sub>1</sub>=25°C (指定のない場合 T<sub>1</sub>=25°C / unless otherwise specified)

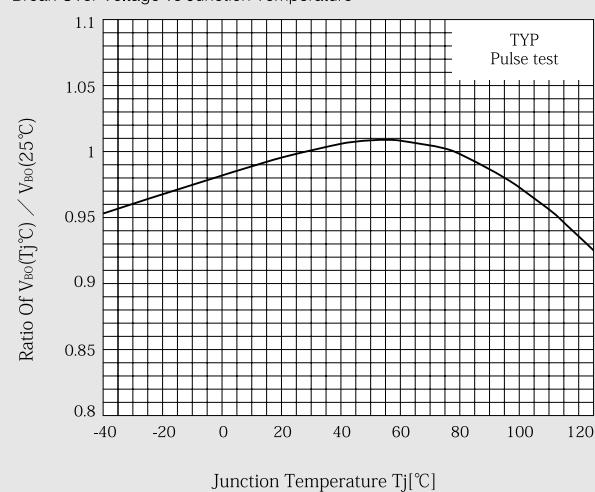
ブレークオーバー電圧 Breakover Voltage	V <sub>BO</sub>	パルス測定 Pulse measurement	MIN 125	V
オフ電流 Off-State Current	I <sub>DRM</sub>	V <sub>D</sub> =V <sub>DRM</sub>	MAX 10	μ A
保持電流 Holding Current	I <sub>H</sub>	パルス測定 Pulse measurement	MIN 100	mA
オン電圧 On-State Voltage	V <sub>T</sub>	I <sub>T</sub> =2A	MAX 3	V
接合容量 Junction Capacitance	C <sub>j</sub>	f=1kHz OSC=1Vrms V <sub>D</sub> =50V	MAX 200	pF
クランピング電圧 Clamping Voltage	V <sub>CL</sub>	dv/dt=100V/ μ s	MAX 195	V

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

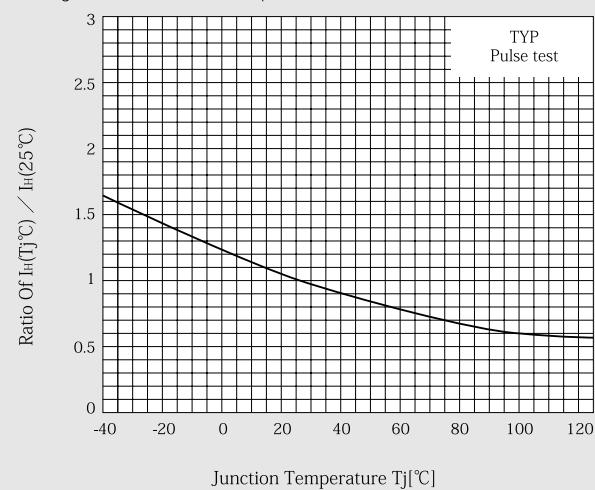
オン電圧 - オン電流  
On-State Voltage vs On-State Current



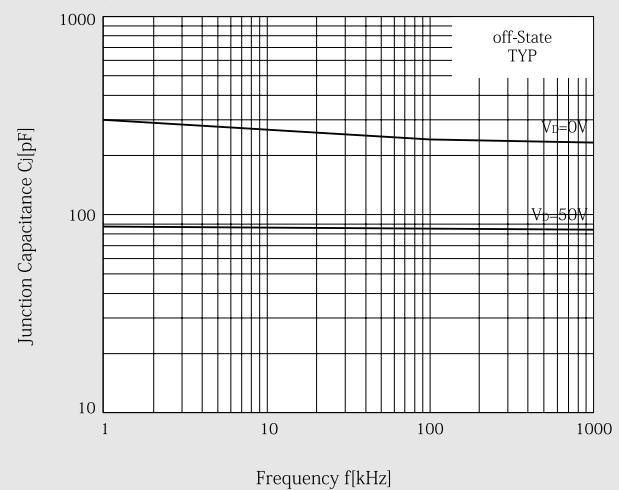
V<sub>BO</sub>-T<sub>J</sub> 特性  
Break Over Voltage vs Junction Temperature



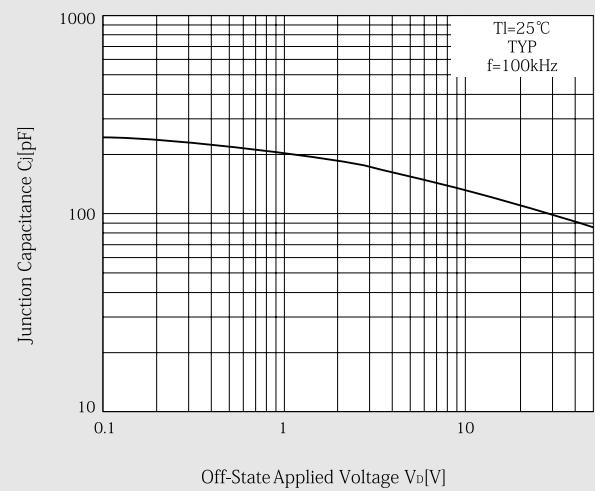
I<sub>H</sub>-T<sub>J</sub> 特性  
Holding Current vs Junction Temperature



接合容量  
Junction Capacitance



接合容量  
Junction Capacitance



\* Sine wave は 50Hz で測定しています。

\* 50Hz sine wave is used for measurements.

\* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。

Typical は統計的な実力を表しています。

\* Semiconductor products generally have characteristic variation.

Typical a statistical average of the devices ability.